




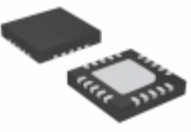



	<h2>SI3477DV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3477DV-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI3477DV-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 110708 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3477DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	110708 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 8A (Tc) 2W (Ta), 4.2W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 4.2W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17.5 mOhm @ 9A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2600pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3477DV-T1-GE3TR

SI3477DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3477DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3477DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3477DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3477DV-T1-E3</b> Son SI3477DV-T1-E3 Son</p>	 <p><b>SI3476DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6</p>	 <p><b>SI3477DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3481DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 4A 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3480-A01-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC CTRLR 4/8-PORT POE 20-QFN</p>	 <p><b>SI3476DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6</p>	 <p><b>SI3480MS8-KIT</b> Energy Micro (Silicon Labs) KIT EVAL 8PORT SI3480/52/SI3500</p>	 <p><b>SI3476DV-T1-E3</b> VISHAY SI3476DV-T1-E3 VISHAY</p>

### heiße Teile

Mehr

SI3469DV-T1	SI3469DV-T1-E3	SI3469DV-T1-E3	SI3469DV-T1-GE3	SI3469DV-T1-GE3
SI3471DV-T1-E3	SI3473CDV-T1-E3	SI3473CDV-T1-E3	SI3473CDV-T1-GE3	SI3473CDV-T1-GE3
SI3473DDV-T1-GE3	SI3473DV-T1-E3	SI3473DV-T1-E3	SI3473DV-T1-GE3	SI3473DV-T1-GE3
SI3474DV-T1-GE3	SI3474DV-T1-GE3	SI3475DV-T1-E3	SI3475DV-T1-E3	SI3475DV-T1-GE3
SI3475DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-E3	SI3476DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-GE3	SI3477DV-T1-E3
SI3477DV-T1-GE3	SI3481DV-T1-E3	SI3481DV-T1-E3	SI3481DV-T1-GE3	SI3481DV-T1-GE3
SI3483CDV-T1-E3	SI3483CDV-T1-E3	SI3483CDV-T1-GE3	SI3483CDV-T1-GE3	SI3483DV-T1-E3
SI3483DV-T1-E3	SI3483DV-T1-GE3	SI3483DV-T1-GE3	SI3493BDV-T1-E3	SI3493BDV-T1-E3
SI3493BDV-T1-E3-S	SI3493BDV-T1-GE3	SI3493BDV-T1-GE3	SI3493DDV-T1-GE3	SI3493DDV-T1-GE3
SI3493DV	SI3493DV-T1	SI3493DV-T1-E3	SI3493DV-T1-E3	SI3493DV-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited